

FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)					電気的特性 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)										外形	備考
				V_{ceo} (V)	V_{cso} (V)	I_c (mA)	P_c (mW)	T_j ($^{\circ}\text{C}$)	I_{cso} 最大値 (μA)	$V_{ce(V)}$	直流又はパルス h_{FE} I_c (mA)	バイアス $V_{ce(V)}$	h_{FE} h_{FE} *	h_{ie} h_{ie} * (Ω)	h_{re} h_{re} * ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{oe} * (μS)	$f_{\alpha b}$ $f_{\alpha b}$ * (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $r_{bb'}$ (real)* (Ω)	
1	2	3	4	5					6	7		8				9		10	11	12

- 1 TYPE NUMBER
- 2 ORIGINAL MANUFACTURER
- 3 USES
- 4 MATERIAL AND STRUCTURE
- 5 MAXIMUM RATINGS
- 6 I_{cso} MAXIMUM VALUE AND V_{ce} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{cso})
- 7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{ce} , I_c (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})
- 8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{ce} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

- 9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T .
- 10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)
- 11 OUTLINE
- 12 REMARKS

: とコンプリ: COMPLEMENTARY TO

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25℃)					電 気 的 特 性 (T _a = 25℃)														外形	備考
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe} h _β *	h _{ie} h _{iβ} * (Ω)	h _{re} h _{rβ} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{oβ} * (μU)	f _{αb} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{re} /real* (Ω)			
									μA	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										
2SB648A	日立	PA	Si.E	-180	-5	-50	1 W	150	-10	-160	60~320	-5	-2	-10	10				140 *	4.5		160	2SD668A とコンプリ	
" 649A	"	"	"	-180	-5	-1.5A	1 W	150	-10	-160	60~320	-5	-150	-5	150				140 *	27		160	2SD669A とコンプリ	
★ " 668A	松下	"	Si.EMe	-80	-5	-3A	25W (T _c =25℃)	150	-200	-60	2000	-3	-500	-3	1.5A			f _{αb} 100kHz			268	ターリントン		
" 669A	"	"	"	-90	-5	-4A	40W (T _c =25℃)	150	-200	-80	3000	-3	-1A	-3	3 A			f _{αb} 100kHz			268	ターリントン		
2SB653A	日立	PA	Si.T	-120	-5	-7A	60W (T _c =25℃)	150	-1mA	-100	60~200	-5	-1A	-5	1 A	t _f =0.5μS			22 *			102	2SD673A とコンプリ	
" 654A	"	"	"	-120	-5	-7A	80W (T _c =25℃)	150	-1mA	-100	60~200	-5	-1A	-5	1 A	t _f =0.5μS			22 *			102	2SD674A とコンプリ	
" 655A	"	"	"	-160	-5	-12A	100W (T _c =25℃)	150	-1mA	-140	60~200	-5	-1A	-5	1 A	t _f =0.5μS			22 *			102	2SD675A とコンプリ	
" 656A	"	"	"	-160	-5	-12A	125W (T _c =25℃)	150	-1mA	-140	60~200	-5	-1A	-5	1 A	t _f =0.5μS			22 *			102	2SD676A とコンプリ	
" 705A	日電	"	"	-150	-5	-10A	120W (T _c =25℃)	150	-50	-140	80	-5	-2A	-5	200				17 *	430		340	2SD745A とコンプリ	
" 705B	"	"	"	-160	-5	-10A	120W (T _c =25℃)	150	-50	-140	80	-5	-2A	-5	200				17 *	430		340	2SD745B とコンプリ	
★ " 706A	"	"	"	-220	-5	-10A	200W (T _c =25℃)	150	-50	-180	80	-5	-2A	-5	200				14 *	450		265	2SD746A とコンプリ	
" 710A	松下	AF	Si.EP	-60	-5	-500	200	125	-0.1	-20	160	-10	-150	-10	50				200 *	6		176	2SD602A とコンプリ	
" 716A	日立	PA	Si.E	-140	-5	-50	750	150	-0.5	-100	250~500	-12	-2	-12	5				150 *	1.8		251	2SD756A とコンプリ	
" 744A	日電	PA.SW	"	-70	-5	-3A	10W (T _c =25℃)	150	-1	-45	100	-5	-500	-5	100				45 *	60		225	2SD794A とコンプリ	
" 748A	日立	PA	Si.T	-120	-5	-6A	60W (T _c =25℃)	150	-1mA	-100	60~200	-5	-1A	-5	1 A	t _f =0.5μS			22 *			332	2SD824A とコンプリ	
" 749A	"	"	"	-120	-5	-7A	80W (T _c =25℃)	150	-1mA	-100	60~200	-5	-1A	-5	1 A	t _f =0.5μS			22 *			332	2SD825A とコンプリ	
" 750A	松下	PA.SW	Si.EP	-80	-5	-2A	35W (T _c =25℃)	150	-1mA	-80	1000~ 10000	-4	-1A			t _{on} =0.2μS, t _{off} =2μS						268	ターリントン	
" 750B	"	"	"	-100	-5	-2A	35W (T _c =25℃)	150	-1mA	-100	1000~ 10000	-4	-1A			t _{on} =0.2μS, t _{off} =2μS						268	ターリントン	
" 751A	"	"	"	-80	-5	-4A	40W (T _c =25℃)	150	-200	-80	1000~ 10000	-3	-3A			t _{on} =0.2μS, t _{off} =2μS						268	ターリントン	
" 751B	"	"	"	-100	-5	-4A	40W (T _c =25℃)	150	-200	-100	1000~ 10000	-3	-3A			t _{on} =0.2μS, t _{off} =2μS						268	ターリントン	
" 766A	"	PA	"	-60	-5	-1A	500	125	-0.1	-20	160	-10	-500	-10	50				200 *	20		336	2SD874A とコンプリ	
2SB502A	東芝	PA	Si.TMe	-110	-10	-3 A	25W (T _c =25℃)	150	-100	-110	80	-5	-500	-10	500	t _{on} =1μS, t _f =1μS t _{off} =3μS			5 *	200		99	2SD877 とコンプリ	
" 503A	"	"	"	-80	-10	-3 A	25W (T _c =25℃)	150	-100	-80	80	-5	-500	-10	500	t _{on} =1μS, t _f =1μS t _{off} =3μS			5 *	200		99		
" 616A	日電	PA.SW	Si.E	-100	-5	-5 A	60W (T _c =25℃)	150	-10	-80	80	-5	-1 A	-5	100				22 *	120		295	2SD586A とコンプリ	
" 700A	日立	PA	Si.T	-160	-5	-12A	100W (T _c =25℃)	150	-1mA	-120	60~200	-5	-1 A	-5	1 A	t _f =0.6μS			20 *			332	2SD736A とコンプリ	
" 702A	"	"	"	-160	-5	-12A	125W (T _c =25℃)	150	-1mA	-140	60~200	-5	-1 A	-5	1 A	t _f =0.6μS			20 *			332	2SD738A とコンプリ	
" 703A	日電	PA.SW	Si.E	-100	-5	-4 A	40W (T _c =25℃)	150	-10	-80	100	-5	-500	-5	100				18 *	110		268	2SD743A とコンプリ	
" 789A	松下	AF	Si.EP	-120	-5	-500	1 W (プリント基板使用)	150			65~330	-10	-150	-10	50				120 *	20		336	2SD968A とコンプリ	
" 793A	"	"	"	-60	-5	-1 A	1 W	150	-0.1	-20	60~340	-10	-500					200 *	20		151			